

シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)

(ダーリントン接続)

# 2SD1413

通信工業用

単位: mm

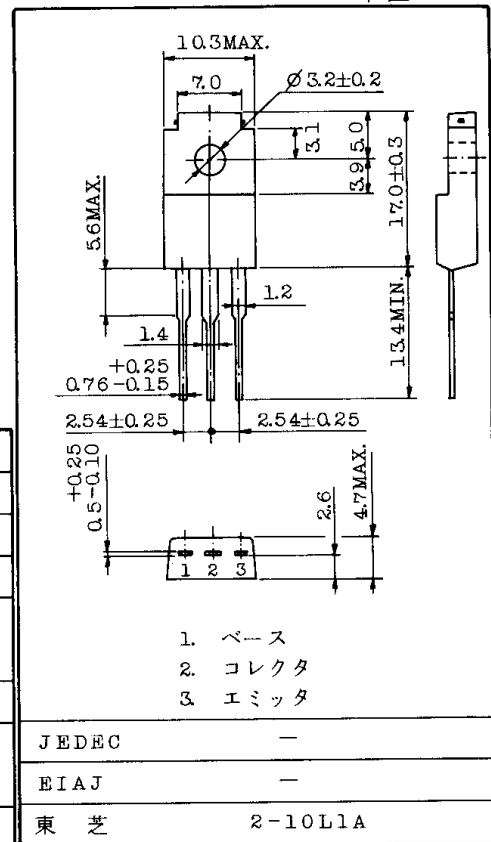
- 0 スイッチング用
- 0 ハンマードライブ, パルスモータードライブ用
- 0 電力増幅用

特長

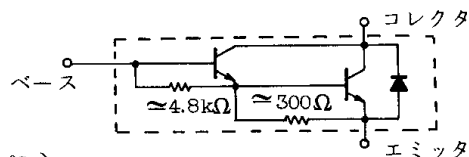
- ・ 直流電流増幅率が高い。  
:  $h_{FE}=2000$  (最小) ( $V_{CE}=2V, I_C=1A$ )
- ・ 飽和電圧が低い。:  $V_{CE(sat)}=1.5V$  (最大) ( $I_C=2A$ )
- ・ 2SB1023とコンプリメンタリになります。

最大定格 ( $T_a=25^\circ C$ )

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	40	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流	DC	$I_C$	3
	パルス	$I_{CP}$	6
ベース電流	$I_B$	0.3	A
コレクタ損失	$T_a=25^\circ C$	$P_C$	2.0
	$T_c=25^\circ C$		20
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ C$



等価回路



電気的特性 ( $T_a=25^\circ C$ )

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=60V, I_E=0$	--	--	20	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5V, I_C=0$	--	--	2.5	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=25mA, I_B=0$	40	--	--	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=2V, I_C=1A$	2000	--	--	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=2V, I_C=3A$	1000	--	--	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2A, I_B=4mA$	--	--	1.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=2A, I_B=4mA$	--	--	2.0	V
スイッチング時間	ターンオン時間	$t_{on}$	--	0.1	--	$\mu s$
	蓄積時間	$t_{etg}$	--	1.0	--	
	下降時間	$t_f$	--	0.2	--	

